

Содержание

● **Неэлектрошнные свойства полупроводников (атомная структура, диффузия)**

Шуман В.Б., Махова А.А., Астров Ю.А., Иванов А.М., Лодыгин А.Н.
О растворимости серы в кремнии 993

● **Электрошнные свойства полупроводников**

Ковалюк З.Д., Боледзюк В.Б., Шевчик В.В., Каминский В.М., Шевченко А.Д.
Ферромагнетизм слоистых полупроводников GaSe, интеркалированных кобальтом 995

Грузинцев А.Н., Загороднев В.Н.
Изменение оптических свойств кристаллов CuI под действием электрического поля 999

Степанов Н.П., Наливкин В.Ю., Гильфанов А.К.
Природа диамагнитного максимума в температурных зависимостях магнитной восприимчивости кристаллов твердых растворов $(\text{Bi}_{2-x}\text{Sb}_x)\text{Te}_3$ ($0 < x < 1$) 1004

● **Поверхность, границы раздела, тонкие пленки**

Комолов А.С., Лазнева Э.Ф., Комолов С.А., Репин П.С., Гавриков А.А.
Потенциальный барьер и фотопотсциал на интерфейсах пленок фторозамещенного и незамещенного фталоцианина меди на поверхности диоксида олова 1012

Павлык Б.В., Слободзян Д.П., Грыпа А.С., Лыс Р.М., Кушлык М.О., Шикоряк И.А., Дидык Р.И.
Совершенство поверхности кристаллов p -Si и радиационно-стимулированные изменения характеристик поверхностно-барьерных структур Bi-Si-Al 1017

● **Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления**

Шевченко Е.А., Жмерик В.Н., Мизеров А.М., Ситникова А.А., Иванов С.В., Торопов А.А.
Квантово-размерный эффект Штарка и локализация носителей в квантовых ямах $\text{Al}_{0.3}\text{Ga}_{0.7}\text{N}/\text{Al}_{0.4}\text{Ga}_{0.6}\text{N}$ с различной морфологией 1022

Калыгина В.М., Валиев К.И., Зарубин А.Н., Петрова Ю.С., Толбанов О.П., Тяжев А.В., Яскевич Т.М.
Электрические характеристики структур n -GaAs-анодная пленка Ga_2O_3 -металл 1027

Синявский Э.П., Карапетян С.А.
Влияние поперечного электрического поля на подвижность в нанопроволоках 1032

Брус В.В.
Об импедансной спектроскопии структур с потенциальным барьером 1035

Чалдышев В.В., Кунделев Е.В., Никитина Е.В., Егоров А.Ю., Горбачевич А.А.
Резонансное отражение света периодической системой экситонов в квантовых ямах GaAs/AlGaAs 1039

● **Углеродные системы**

Садыков Н.Р., Скоркин Н.А.
Воздействие нестационарного электрического поля с различным профилем переднего фронта на углеродные нанотрубки 1043

● **Физика полупроводниковых приборов**

Жуков А.Е., Асрян Л.В., Шерняков Ю.М., Максимов М.В., Зубов Ф.И., Крыжановская Н.В., Yvind К., Семенова Е.С.
Влияние асимметричных барьерных слоев в волноводной области на температурные характеристики лазеров на квантовой яме 1049

Бочкарева Н.И., Вороненков В.В., Горбунов Р.И., Зубрилов А.С., Латышев Ф.Е., Леликов Ю.С., Ребане Ю.Т., Цюк А.И., Шретер Ю.Г.
Влияние хвостов локализованных состояний в InGaN на уменьшение эффективности GaN-светодиодов с ростом плотности тока 1054

Крыжановская Н.В., Жуков А.Е., Надточий А.М., Словинский И.А., Максимов М.В., Кулагина М.М., Савельев А.В., Аракчеева Е.М., Задиранов Ю.М., Трошков С.И., Липовский А.А.
Высокотемпературная лазерная генерация в микрокольцевом лазере с активной областью на основе квантовых точек InAs/InGaAs 1063

Соколова З.Н., Тарасов И.С., Асрян Л.В.
Влияние числа квантовых ям в активной области на линейность ватт-амперной характеристики полупроводникового лазера 1067

Минтаиров М.А., Евстропов В.В., Калюжный Н.А., Минтаиров С.А., Тимошина Н.Х., Шварц М.З., Лантратов В.М.
Фотоэлектрическое определение последовательного сопротивления многопереходных солнечных элементов 1074

Алиев К.М., Камилов И.К., Ибрагимов Х.О., Абакарова Н.С.
Отрицательное дифференциальное сопротивление N-типа, гистерезис и осцилляции на вольт-амперных характеристиках сверхвысокочастотных диодов 1082

Кольцов Г.И., Диденко С.И., Черных А.В., Черных С.В., Чубенко А.П., Свешников Ю.Н.
Контакты Шоттки к высокоомным эпитаксиальным слоям GaAs для детекторов частиц и квантов 1088

- **Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур**

Грузинцев А.Н., Емельченко Г.А., Дулина Н.А., Ермаолаева Ю.В., Толмачев А.В.

Лазерная генерация нанокompозитов Y_2O_3-ZnO сферической формы 1094

Леньшин А.С., Кашкаров В.М., Середин П.В., Минаков Д.А., Агапов Б.Л., Кузнецова М.А., Мошников В.А., Домашевская Э.П.

Исследования морфологических особенностей роста и оптических характеристик многослойных образцов пористого кремния, выращенных на подложках *n*-типа с эпитаксиально нанесенным p^+ -слоем 1101

Пашаев И.Г.

Влияние различных обработок на свойства диодов Шоттки 1108

Саидов А.С., Усмонов Ш.Н., Асатова У.П.

Выращивание пленок твердого раствора $Ge_{1-x}Sn_x$ и исследование их структурных и некоторых фотоэлектрических свойств 1111